

نمونه ای از ترجمه مقاله :

# نقش مدل‌های ترانزیستور با فرکانس بالا در کاربردهای کم نویز

## High Frequency Transistor Models for Low Noise Applications

Manfred Berroth, Andreas Pascht, Dirk Wiegner  
Institute of Electrical and Optical Communication Engineering  
University of Stuttgart  
Pfaffenwaldring 47  
70550 Stuttgart, Germany

برای خرید ترجمه فارسی این مقاله (با فرمت ورد) همراه با  
مقاله انگلیسی [اینجا](#) کلیک نمایید.

## فروشگاه اینترنتی ایران عرضه

## Abstract

Mobile communication is one of the fastest growing markets and demands a significant part of the integrated circuit sales. In the past transceivers in the GHz range have required silicon bipolar transistors or even GaAs devices. With the scaling of CMOS technology commercial fabrication lines offer n-channel MOSFET devices with a transit frequency beyond 20 GHz for very large scale integrated circuits. This paper compares the high frequency characteristics of the MOSFET with the SiGe heterostructure bipolar transistor and the GaAs based HEMT for low noise applications.

## چکیده :

یکی از سریعترین بازارهای در حال رشد ، بازار ارتباط سیار (متحرک) بوده و بخش قابل توجهی از فروش مدار مجتمع را به خود اختصاص می دهد. در گذشته، دستگاههای گیرنده و فرستنده در محدوده GHz نیاز به ترانزیستورهای دو قطبی سیلیکونی یا حتی دستگاههای GaAs داشتند. با مقیاس بندی فناوری CMOS ، خطوط ساخت تجاری دستگاههای n کانالی MOSFET با فرکانس گذر بیشتر از 20GHz برای مدارهای مجتمع بسیار بزرگ عرضه می کنند. این مقاله، ویژگیهای MOSFET با فرکانس بالا را با ترانزیستور دو قطبی غیر هم ساختار SiGe و HEMT متکی بر GaAs در کاربردهای کم نویز را باهم مقایسه می کند .

برای خرید ترجمه فارسی این مقاله (با فرمت ورد) همراه با مقاله انگلیسی **اینجا** کلیک نمایید.

iran arze.ir

مرجع مقالات ترجمه شده